

Procedeu de obținere a cristalului fotonice care include depunerea unei măști pe una din suprafețele cristalului de semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu pași egali, implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măștii în patru direcții și decaparea electrochimică, caracterizat prin aceea că la implantare fiecare direcție a ionilor formează un unghi de 45° față de normala la suprafața cristalului, iar unghiurile dintre direcțiile ionilor sunt egale cu 90° .